

Аверкиев Никита Сергеевич

Ученая степень - доктор физико-математических наук, 01.04.10 - физика полупроводников.

Ученое звание – профессор.

Должность – Заведующий сектором теории оптических и электрических явлений в полупроводниках Центра физики наногетероструктур

Полное и сокращенное название организации (основное место работы):

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Телефон: +7 812 297 7155

Телефон мобильный: +7 921 794 0202

e-mail: averkiev@les.ioffe.ru

Список основных публикаций по теме диссертации за 5 лет

1. Rozhansky, I.V. Split-off states in tunnel-coupled semiconductor heterostructures for ultrafast modulation of spin and optical polarization / I.V. Rozhansky, V. N. Mantsevich, N. S. Maslova, P. I. Arseyev, N. S. Averkiev, and E. Lähderanta // Physical Review B. – 2020. – Vol. 101. – P. 045305. –
2. Kokurin, A. Sign-reversal electron magnetization in Mn-doped semiconductor structures/ A. Kokurin, A. Yu. Silov, and N. S. Averkiev// Physical Review B. – 2020. – Vol. 102. – P. 041202(R). –
3. Denisov, K. S. Chiral spin ordering of electron gas in solids with broken time reversal symmetry/ K. S. Denisov, I.V. Rozhansky, N. S.Averkiev, E. Lähderanta// SCIENTIFIC REPORTS. – 2019. – Vol. 9. – P.10817. –
4. Denisov, K. S. General theory of the topological Hall effect in systems with chiral spin textures / K. S. Denisov, I. V. Rozhansky, N. S. Averkiev, E. Lähderanta// Physical Review B. – 2020. – Vol. 102. – P.041202(R). –
5. Bogoslovskiy, N. A. Two components of donor-acceptor recombination in compensated semiconductors: Analytical model of spectra in the presence of electrostatic fluctuations / N. A. Bogoslovskiy, P. V. Petrov, Yu. L. Ivánov, K. D. Tsendin, and N. S. Averkiev // Physical Review B. – 2018. – Vol. 98. – P.075209. –
6. Maslova, N. S. Dynamic spin injection into a quantum well coupled to a spin-split bound state /N. S. Maslova, I. V. Rozhansky, V. N. Mantsevich, P. I. Arseyev, N. S. Averkiev, E. Lähderanta // Physical Review B. – 2018. – Vol. 97. – P. 195445. –
7. Bushuykin, P. A. New photoelectrical properties of InN: Interband spectra and fast kinetics of positive and negative photoconductivity of InN / P. A. Bushuykin, B. A. Andreev, V. Yu. Davydov, D. N. Lobanov, D. I. Kuritsyn, A. N. Yablonskiy, N. S. Averkiev, G. M. Savchenko, and Z. F. Krasilnik // J. Appl. Phys. – 2018. – Vol. 123. – P. 195701. –

8. Dimitriev, G. S. Confinement effect on hole polarization in (Ga,Mn)As/AlAs diluted magnetic semiconductor multiple quantum wells / G. S. Dimitriev, V. F. Sapega, N. S. Averkiev, I. E. Panaiotti, K. H. Ploog // *Phys. Solid State* . – 2017. – Vol. 59. – P. 2262. –
9. Krainov, , M. Carrier spin relaxation in diluted magnetic quantum wells: Effect of Mn spin correlations / V. Krainov, M. Vladimirova, D. Scalbert, E. Lähderanta, A. P. Dmitriev, and N. S. Averkiev // *Physical Review B*. – 2017. – Vol. 96. – P. 165304. –
10. Vasileva, G. Yu. Strongly temperature dependent resistance of meander-patterned graphene / G. Yu. Vasileva, D. Smirnov, Yu. B. Vasilyev, M. O. Nestoklon, N. S. Averkiev, S. Novikov, I. I. Kaya, and R. J. Haug // *Appl. Phys. Lett.* – 2017. – Vol. 110. – P. 113104. –
11. Averkiev, N.S. Acoustic Properties of Crystals with Jahn–Teller Impurities: Elastic Moduli and Relaxation Time. Application to SrF₂:Cr²⁺ / N.S. Averkiev, I.B. Bersuker, V.V. Gudkov, I.V. Zhevstovskikh, M.N. Sarychev, S. Zherlitsyn, S. Yasin, G.S. Shakurov, V.A. Ulanov, and V.T. Surikov // *J. Phys. Soc. Jpn.* – 2017. – Vol. 2086.– P. 114604. –
12. Averkiev, N. S. Magnetic field induced tunneling and relaxation between orthogonal configurations in solids and molecular systems / N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, I. V. Zhevstovskikh, K. A. Baryshnikov, M. N. Sarychev, S. Zherlitsyn, S. Yasin, and Yu. V. Korosteli // *Physical Review B*. – 2017. – Vol. 96.– P. 094431. –